

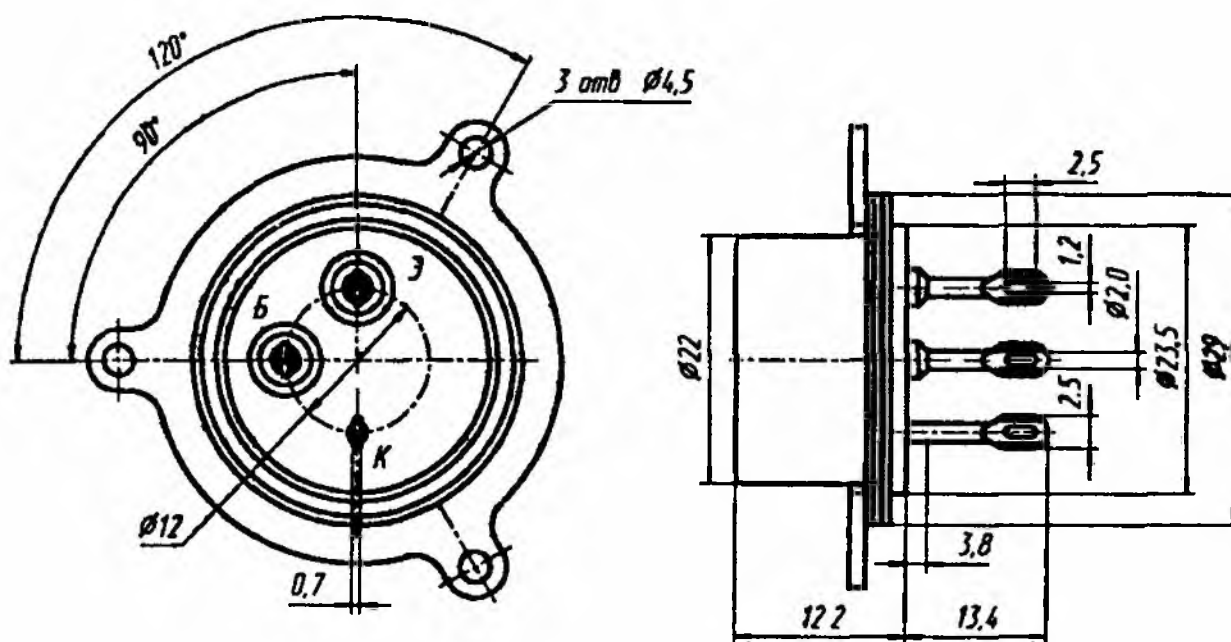
1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В, ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры *p-n-p* переключательные. Предназначены для применения в импульсных устройствах, преобразователях и стабилизаторах тока и напряжения. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 28 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

1Т806(А-В), ГТ806(А-Д)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ (на границе насыщения):

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В:

при $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$, $I_K = 10\text{ А}$	10...100
при $T = +70\text{ }^\circ\text{C}$, $I_K = 5\text{ А}$	10...100
при $T = -60\text{ }^\circ\text{C}$, $I_K = 10\text{ А}$	10...150

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д:

при $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$, $I_K = 10\text{ А}$	10...100
при $T = +55\text{ }^\circ\text{C}$, $I_K = 5\text{ А}$	10...200
при $T = -55\text{ }^\circ\text{C}$, $I_K = 10\text{ А}$	8...100

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 5\text{ В}$, $I_K = 1\text{ А}$,

не менее 10 МГц

Граничное напряжение при $I_B = 3\text{ А}$,

$t_{и} < 50$ мкс, $f = 20...50$ Гц, не менее:

1Т806А	40 В
1Т806Б	65 В
1Т806В	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, не более:

при $I_k = 20$ А, $I_b = 2$ А для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	0,6 В
--	-------

при $I_k = 15$ А, $I_b = 2$ А для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	0,6 В
--	-------

Напряжение насыщения база—эмиттер, не более:

при $I_k = 20$ А, $I_b = 2$ А для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	0,8 В
--	-------

при $I_k = 15$ А, $I_b = 2$ А для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	1 В
--	-----

Время выключения при $U_{кз} = 45$ В, $I_k = 5$ А, $I_b = 0,25$ А, не более

30 мкс

Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{бэ} = 1$ В, $U_{кз} = 75$ В для 1Т806А, $U_{кз} = 100$ В для 1Т806Б, $U_{кз} = 120$ В для 1Т806В, не более:

$T = +25$ и -60 °С	12 мА
----------------------------	-------

$T = +70$ °С	25 мА
--------------------	-------

$T = +25$ °С, $U_{кз} = U_{кз, макс}$ для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д.....

15 мА

Обратный ток эмиттера, не более:

при $U_{бэ} = 2$ В для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	5 мА
---	------

при $U_{бэ} = 1,5$ В для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	8 мА
---	------

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $U_{бэ} = 1$ В:

1Т806А, ГТ806А	75 В
----------------------	------

1Т806Б, ГТ806Б	100 В
----------------------	-------

1Т806В, ГТ806В	120 В
----------------------	-------

ГТ806Г	50 В
--------------	------

ГТ806Д	140 В
--------------	-------

Постоянное напряжение база—эмиттер:

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.....	2 В
-----------------------------	-----

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	1,5 В
--	-------

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения:

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.....	20 А
-----------------------------	------

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	15 А
Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при $Q \geq 2$, $t_{и} = 1000$ мкс, $K_{НАС} = 1$ для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	25 А
Постоянный ток базы	3 А
Постоянно рассеиваемая мощность коллектора ¹ :	
с теплоотводом, $T_K \leq +25$ °С	30 Вт
без теплоотвода, $T \leq +25$ °С	2 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	2 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—среда	30 °С/Вт
Температура р-п перехода	+85 °С
Температура окружающей среды:	
1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В	-60... $T_K =$ = +70 °С
ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .	-55... $T_K =$ = +55 °С

¹ При $T_K > +25$ °С для транзисторов с теплоотводом

$$P_{K, \text{МАКС}} = (85 - T_K) / R_{T(p-K)}, \text{ Вт};$$

при $T > +25$ °С для транзисторов без теплоотвода

$$P_{K, \text{МАКС}} = (85 - T) / R_{T(p-C)}, \text{ Вт}.$$

Не допускается отключение базы при наличии напряжения между коллектором и эмиттером. Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во всем диапазоне температур.

Эксплуатация транзисторов в режимах за пределами областей максимальных режимов (в том числе с учетом процессов, происходящих при включении и выключении) запрещается. При работе в импульсном режиме при отсутствии открывающего импульса транзистор должен быть закрыт положительным смещением базы $0,5 \text{ В} \leq U_{БЭ} \leq 2 \text{ В}$.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора. При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен присоединяться последним и отсоединяться первым.